

# EUROPEAN PATENT OFFICE

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 02239188  
PUBLICATION DATE : 21-09-90

APPLICATION DATE : 09-03-89  
APPLICATION NUMBER : 01058247

APPLICANT : NIPPON MINING CO LTD;

INVENTOR : IZUMI SEIICHI;

INT.CL. : C30B 25/18 // C30B 29/40 H01L 21/205

TITLE : EPITAXIAL GROWTH METHOD

ABSTRACT : PURPOSE: To drastically lower an abnormally grown defect by performing specified specular finishing on the surface of a wafer and specifying the temp. of a base plate in the case of growing an epitaxial layer on the surface of the wafer by an organic metallic vapor phase epitaxial growth method.

CONSTITUTION: Epitaxial growth is performed by utilizing a wafer wherein the face orientation is tilted at 0.1-0.5° preferably 0.1-0.2° from (100) direction and raising the temp. of a base plate at 600-700°C. By this method, an epitaxial layer is grown uniformly and densely in the whole surface and a defect accompanied with growth is made difficult to be caused. Further the range of a product heretofore called as a face orientation just article is limited at ≤0.1° off angle. This is discriminated from the wafer having 0.1-0.5° off angle and therefore it can be prevented that the defect is caused or not on the surface of the epitaxial layer.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

平2-239188

⑫ Int.Cl.<sup>5</sup>

C 30 B 25/18  
// C 30 B 29/40  
H 01 L 21/205

識別記号

府内整理番号

8518-4G  
8518-4G  
7739-5F

⑬ 公開 平成2年(1990)9月21日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 エピタキシャル成長方法

⑮ 特願 平1-58247

⑯ 出願 平1(1989)3月9日

⑰ 発明者 菅 和彦 埼玉県戸田市新曾南3丁目17番35号 日本鉱業株式会社電子材料・部品研究所内

⑰ 発明者 甲斐莊敬司 埼玉県戸田市新曾南3丁目17番35号 日本鉱業株式会社電子材料・部品研究所内

⑰ 発明者 泉 清一 埼玉県戸田市新曾南3丁目17番35号 日本鉱業株式会社電子材料・部品研究所内

⑰ 出願人 日本鉱業株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

⑰ 代理人 弁理士 大日方 富雄 外1名

明細書

1. 発明の名称

エピタキシャル成長方法

2. 特許請求の範囲

(1) 化合物半導体単結晶ウェーハの表面を、その面方位が<100>方向から角度で0.1~0.5°傾くように鏡面加工した後、その表面に有機金属気相エピタキシャル法により、基板温度が600~700°Cの条件でエピタキシャル層を成長させるようにしたことを特徴とするエピタキシャル成長方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ウェーハ上へのエピタキシャル成長技術に関し、特に化合物半導体単結晶ウェーハ上にMOCVD(有機金属気相エピタキシャル成長法)によりエピタキシャル層を形成する場合に利用して効果的な技術に関する。

[従来の技術]

従来、MOCVDやMBE(分子線エピタキシ

ー)、クロライドCVD、ハイドライドCVDなどの気相エピタキシャル成長法によって化合物半導体単結晶ウェーハ上にエピタキシャル層を成長させた場合、グロースピラミッド(growth pyramids)やファセッテッドディフェクト(faceted defects)と呼ばれる表面欠陥が生じるという問題があった。

上記問題を解決するため、例えばウェーハの成長面を<100>方位から1~7°傾けて気相成長を行なう方法(以下、オフアングル法と称する)が提案されている('Journal of Crystal Growth 88' Elsevier Science Publishers B.V., Nouth-Holland Physics Publishing Division) pp53~pp66)。

面方位を1~7°傾けるという上記オフアングル法にあっては、主として転位の上に発達するグロースピラミッドやファセッテッドディフェクトと呼ばれる欠陥を、著しく低減させることができ

る。

〔発明が解決しようとする課題〕

ところで、従来、半導体レーザのように結晶表面にグレーティングを施さなければならないデバイスの材料には上述したようなオフアングルのウェーハを使用することはできないため、面方位が<100>ジャストと呼ばれるものが使用されていた。しかし、従来の面方位ジャスト品を用いて気相成長を行なうと、エピタキシャル成長層の表面に欠陥が現われたり現われなかったりする場合があった。

この発明は上記のような背景の下になされたもので、その目的とするところは、ウェーハ表面にMOCVDによるエピタキシャル層を形成する場合において、成長膜の表面に生じる異常成長欠陥を大幅に低減できるようなエピタキシャル成長方法を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

本発明者らは、従来の面方位ジャスト品を用いて気相成長させたウェーハの表面に欠陥が現われ

でエピタキシャル成長させることを提案するものである。

〔作用〕

上記した手段によれば、エピタキシャル層の成長面の面方位が0.1~0.5°傾いているため結晶格子を構成する原子層の端部が表面に階段状に現われ、そこをシードとしてエピタキシャル層が成長を開始し、基板温度を600°C以上700°C以下と高く設定しているので、表面全体に亘って均一かつ緻密にエピタキシャル層が成長し、成長に伴う欠陥が生じにくくなる。

また、従来、面方位ジャスト品と呼ばれていた製品の範囲を、オフアングル0.1°以下に限定し、それとオフアングル0.1~0.5°のものを区別しているため、エピタキシャル層の表面に欠陥が現われたり現われなかったりするのを防止できる。

〔実施例〕

以下、本発明を、InP基板上へMOCVD法によりInP結晶をエピタキシャル成長させる場

たり現われなかったりする原因を究明すべく、種々の実験を繰り返した結果、従来の面方位ジャスト品と呼ばれるものの中には、オフアングルが0.5°以下のものが含まれていること、また、気相成長に伴う表面欠陥は、上記グロースピラミッドやファセッテッドディフェクトだけではなく、第2図(A)に示すような涙状の異常成長欠陥(以下、涙状欠陥と称する)があり、この涙状欠陥は0.5°以下のオフアングルウェーハ上に気相成長を行なう際に生じ、オフアングルが0.1°以下ではそれは最大10<sup>4</sup>~10<sup>5</sup>cm<sup>-2</sup>にも達することを見出した。

なお、第2図は微分干涉顕微鏡写真であり、ここに現われている涙状欠陥は、成長層の厚さが3μmの円形または梢円形の突起物である。

この発明は、上記知見に基づいて、MOCVD法によるエピタキシャル成長法用基板として、面方位を<100>方向から0.1~0.5°好ましくは0.1~0.2°傾けたウェーハを用い、かつ基板温度を600°C以上700°C以下の条件

合を例にとって説明する。

先ず、成長を行なうInP基板として、基板表面が面方位<100>より0.5°以内の適当な角度に傾くように鏡面加工したものを使ふことを意した。次に、各InP基板の面方位を正確に測定してから、その表面にMOCVD法によりエピタキシャル層を3μmの厚みに成長させた。なお、このMOCVD法によるエピタキシャル成長ではⅢ族原料としてトリメチルインジウムを用い、これを1.2×10<sup>-4</sup>mol/分の流量で流すとともに、V族原料にはホスフィン(PH<sub>3</sub>)を用い、これを1.2×10<sup>-3</sup>mol/分の流量で流し、基板温度650°C、成長室内圧力76torrの条件で減圧成長を行なった。このとき、エピタキシャル層の成長速度は1μm/時間であった。

上記のようにして気相成長されたInP基板の表面を微分干涉顕微鏡で観察して、表面欠陥(涙状欠陥)の密度を測定した結果を第1図に示す。第1図は表面欠陥密度を縦軸、基板表面の面方位の傾き(オフアングル)を横軸にとって示してあ

特開平2-239188(3)

る。

第1図より、面方位のずれが0.05°以内の基板の表面に形成されたエピタキシャル成長層の表面欠陥密度は、 $1.5 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}$ 以上であるが、0.05°～0.10°のオフアングルの基板では表面欠陥密度が $1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}$ の範囲に減少し、さらに、0.10°以上のオフアングルの基板では、 $3 \times 10^2 \text{ cm}^{-2}$ 以下に減少していることが分かる。

また、第2図(A)、(B)にはオフアングルが0.03°と0.2°のInP基板上に成長させたエピタキシャル層の表面の微分干渉顕微鏡写真をそれぞれ示す。

同図より、基板表面の傾きが0.03°の場合よりも0.2°の方が大幅にエピタキシャル層の表面欠陥が少ないことが分かる。

この実施例では基板650°Cでエピタキシャル成長させているが、基板温度は600～700°Cの範囲とされる。600°C未満では表面欠陥密度を十分に低減できず、700°Cを超えるとキャリ

ア濃度が高くなるからである。

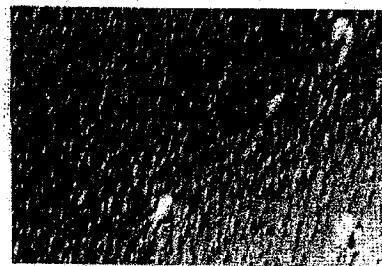
なお、上記実施例ではInP基板上にエピタキシャル層を成長させる場合を例にとって説明したが、この発明はInP基板のみでなく、GaAs等他の化合物半導体基板に適用できる。

#### [発明の効果]

以上説明したように、この発明は、化合物半導体単結晶ウェーハの表面を、その面方位がく100°方向から角度で0.1～0.5°傾くように鏡面加工した後、その表面に有機金属気相エピタキシャル法により、基板温度が600～700°Cの条件でエピタキシャル層を成長させるようにしたので、エピタキシャル層の成長面の面方位が0.1～0.5°傾いているため結晶格子を構成する原子層の端部が表面に階段状に現われ、そこをシードとしてエピタキシャル層が成長を開始するようになり、また基板温度を600～700°Cと高く設定しているので、表面全体に亘って均一かつ緻密にエピタキシャル層が成長し、成長に伴う欠陥が生じにくくなる。

第2図

(A) ×100



(B)



代理人弁理士 大日方富雄  
弁理士荒船博司